60　デジタル方式の記録装置であって、次の⑴及び⑵に該当するもの
⑴　ディスクメモリ又はソリッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が6.4ギガビット毎秒を超えて維持可能なもの
⑵　記録中に無線周波数信号データを解析することができるプロセッサを有するもの
61　スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの（定比幅フィルターのみを用いたものを除く。）
⑴　31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、３デシベルの分解能帯域幅が10メガヘルツを超えるもの
⑵　43.5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、表示平均ノイズレベルがマイナス150ディービーエム毎ヘルツ未満のもの
⑶　90ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
⑷　次のア及びイに該当するもの
ア　実時間帯域幅が170メガヘルツを超えるもの
イ　次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が３デシベル未満であって、15マイクロ秒以下の長さの信号を100パーセントの確率で検出するもの
(ｲ)　周波数マスクトリガー機能を有するものであって、15マイクロ秒以下の長さの信号を100パーセントの確率で捉えることができるもの
62　信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、次のア及びイに該当するパルス変調信号を発振するもの
ア　パルス幅が25ナノ秒未満のもの
イ　オン・オフ比が65デシベル以上のもの
⑵　43.5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力100ミリワット（20ディービーエム）を超えるもの
⑶　次のいずれかに該当するもの
ア　4.8ギガヘルツ超31.8ギガヘルツ以下の出力周波数範囲において、2.2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
イ　31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下の出力周波数範囲において、550メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が500マイクロ秒未満のもの
ウ　37ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下の出力周波数範囲において、2.2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
63　ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
⑴　43.5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が31.62ミリワット（15ディービーエム）を超えるもの
⑵　90ギガヘルツ超110ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が１ミリワット（０ディービーエム）を超えるもの
⑶　50ギガヘルツ超110ギガヘルツ以下の周波数帯域において、非線形ベクトルの計測機能を有するもの（⑴又は⑵に該当するものを除く。）
⑷　最大動作周波数が110ギガヘルツを超えるもの
64　マイクロ波用試験受信機であって、次の⑴及び⑵に該当するもの
⑴　110ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
⑵　振幅及び位相を同時に測定できるもの
65　原子周波数標準器であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　宇宙用に設計したもの
⑵　ルビジウムを用いていないものであって、30日間連続して発振したときの安定度が1,000億分の１未満のもの
⑶　宇宙用に設計していないものであって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　ルビジウムを用いたもの
イ　30日間連続して発振したときの安定度が1,000億分の１未満のもの
ウ　消費電力が１ワット未満のもの
66　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品
⑴　イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの
ア　水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの
イ　直接描画を行うことができるもの
ウ　加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合において、ビームエネルギーが65キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が45ミリアンペア以上のもの
エ　600度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの
⑵　リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの
ア　ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　光源の波長が193ナノメートル未満のもの
(ｲ)　ナノメートルで表した光源の波長に0.35を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が45以下のもの
イ　インプリントリソグラフィ装置であって、45ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの
ウ　マスクの製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いたもの
エ　直接描画方式で半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置
⑶　マスク又はレチクルであって、集積回路の製造用のもの
⑷　試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア　31.8ギガヘルツを超える周波数において、トランジスタのエスパラメータを試験することができるように設計したもの
イ　49⑵に該当するマイクロ波集積回路の試験を行うことができるように設計したもの
67　シリコン、ゲルマニウム、炭化けい素、又はⅢ－Ⅴ族化合物（ガリウム又はインジウムの化合物に限る。）の多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板（次のいずれかの化合物のＰ型エピタキシャル層を１層以上有し、かつ、当該Ｐ型エピタキシャル層がＮ型層に挟まれていないものを除く。）
⑴　窒化ガリウム
⑵　窒化インジウムガリウム
⑶　窒化アルミニウムガリウム
⑷　窒化インジウムアルミニウム
⑸　窒化インジウムアルミニウムガリウム
⑹　リン化ガリウム
⑺　砒化（ひか）ガリウム
⑻　砒化（ひか）アルミニウムガリウム
⑼　リン化インジウム
⑽　リン化インジウムガリウム
⑾　リン化アルミニウムインジウム
⑿　リン化インジウムガリウムアルミニウム